

9013

硅 NPN 外延平面晶体管芯片 (4 ")

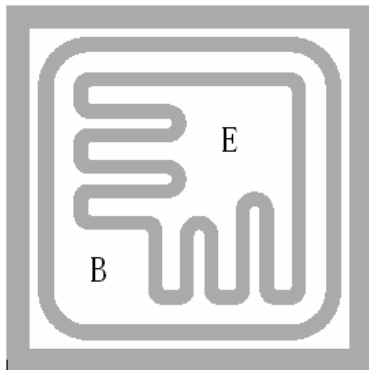
■用途:

- *一般用途放大器
- *中等功率驱动器
- *中速开关应用

■特征:

- *优越的 h_{FE} 线性
- *与 9012 配对
- *集电极电流:0.5A
- *有效管芯数(只):33400

■芯片示意图



■芯片结构

芯片尺寸	460 μ m × 460 μ m
压焊区尺寸	基 区 117 μ m × 117 μ m 发射区 130 μ m × 130 μ m
芯片厚度	220 ± 10 μ m
锯片槽尺寸	56 μ m
金属层	正面:Al 1.85 ± 0.15 μ m 背面:Au 1.1 ± 0.2 μ m

■电特性(Ta=25°C)

参 数 名 称	符 号	测 试 条 件	最 小	最 大	单 位
集电极--基极击穿电压	BV_{CBO}	$I_C=100 \mu A, I_E=0$	40		V
集电极--发射极击穿电压	BV_{CEO}	$I_C=1mA, I_B=0$	20		V
发射极--基极击穿电压	BV_{EBO}	$I_E=100 \mu A, I_C=0$	5		V
集电极--基极截止电流	I_{CBO}	$V_{CB}=25V, I_E=0$		200	nA
发射极--基极截止电流	I_{EBO}	$V_{EB}=4V, I_C=0$		200	nA
直流电流增益	h_{FE}	$V_{CE}=1V, I_C=50mA$	80	600	
集电极--发射极饱和电压	$V_{CE(sat)}$	$I_C=500mA, I_B=50mA$		0.6	V